



DIODA ELEKTROLUMINESCENCYJNA

CQYP 43

Dioda elektroluminescencyjna z GaAs/GaAlAs wykonana została techniką wielowarstwowej epitaksji w zahermetyzowanej obudowie metalowo-szklanej. Obszar emisji promieniowania usytuowano centrycznie względem ścianek obudowy.

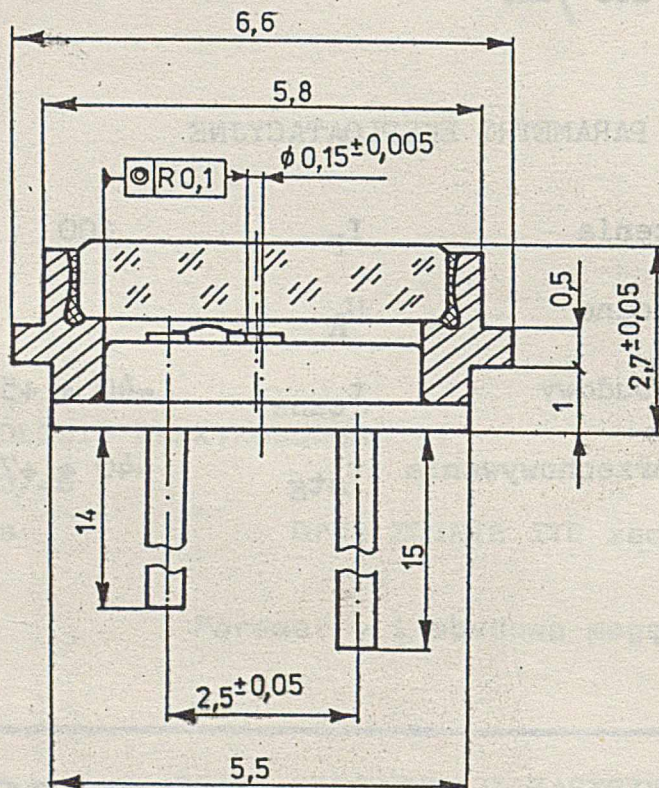
Dioda stanowi element czynny w złączeniu nadajnikowym przystosowanym do wielokrotnego łączenia ze światłowodem o średnicy rdzenia $\phi_r = 200 \mu\text{m}$.

DOPUSZCZALNE PARAMETRY EKSPLOATACYJNE

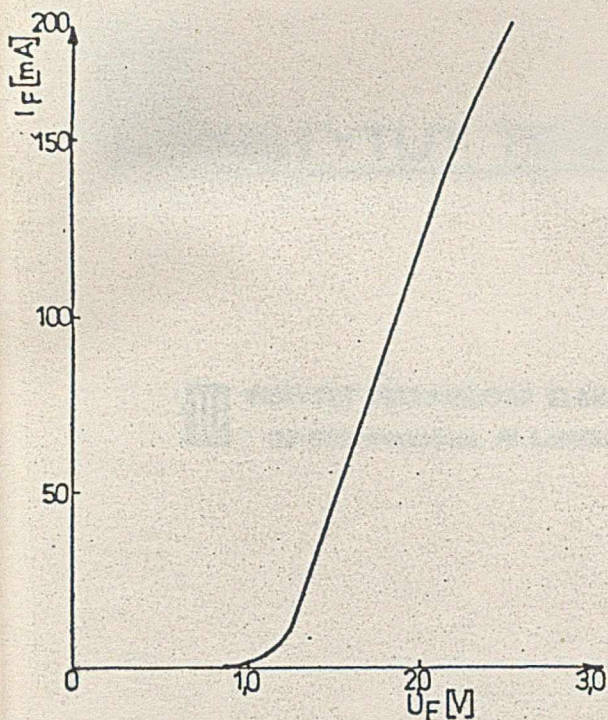
Prąd przewodzenia	I_F	100	mA
Napięcie wsteczne	U_R	2	V
Temperatura obudowy	t_{case}	-40 + +55	°C
Temperatura przechowywania	t_{stg}	-40 + +70	°C

PARAMETRY CHARAKTERYSTYCZNE

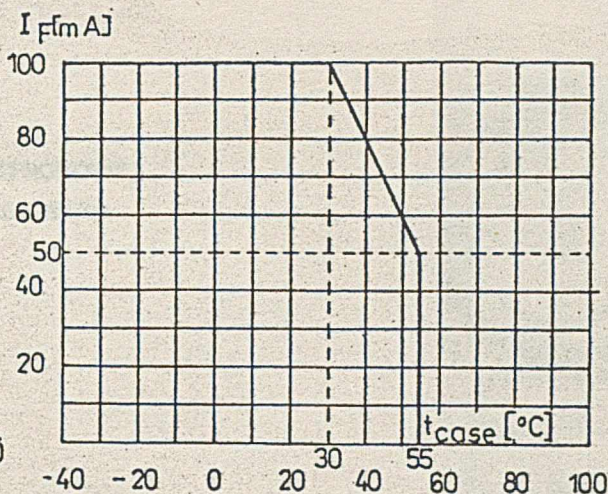
Nazwa parametru	Symbol	Jedn.	Wartość			Warunki pomiaru
			min.	typ.	max.	
Moc promieniowania	P_e	mW	2	3	-	$I_F = 100 \text{ mA}$
Napięcie przewodzenia	U_F	V	-	1,8	2,5	$I_F = 100 \text{ mA}$
Długość fali odpowiadająca maksimum charakterystyki widmowej	λ_p	nm	800	-	900	$I_F = 100 \text{ mA}$
Szerokość połówkowa widma promieniowania	$\Delta\lambda_{0,5}$	nm	-	40	50	$I_F = 100 \text{ mA}$
Prąd wsteczny	I_R	μA	-	-	100	$U_R = 2 \text{ V}$
Niewspółosiowość obszaru emisji względem ścianek bocznych obudowy	Δ	μm	-	50	100	_____



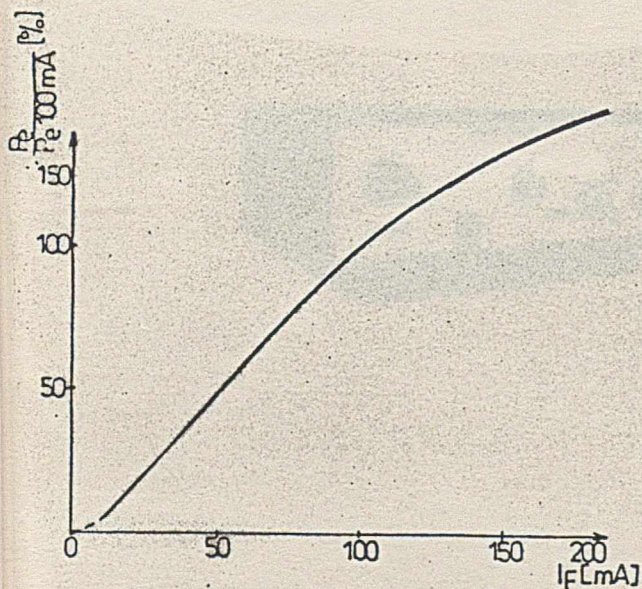
Rys. 1. Obudowa CQYP 43



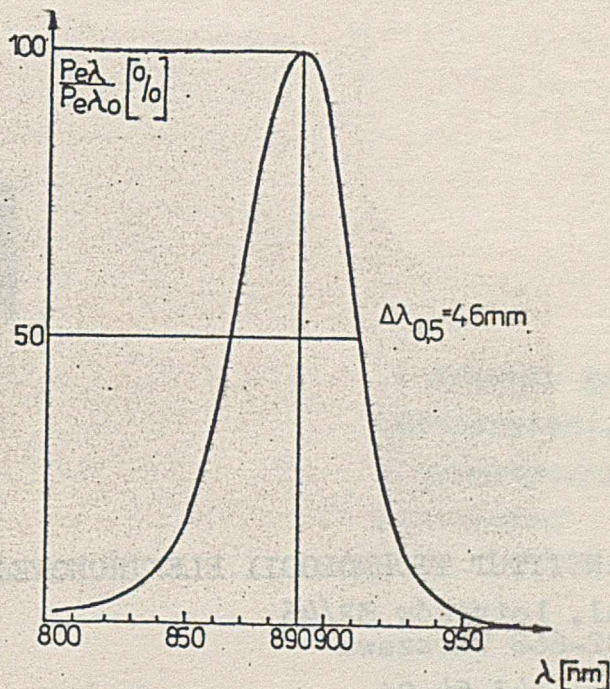
Rys. 2. Charakterystyka prądowo-napięciowa



Rys. 3. Zależność dopuszczalnego prądu przewodzenia od temperatury obudowy

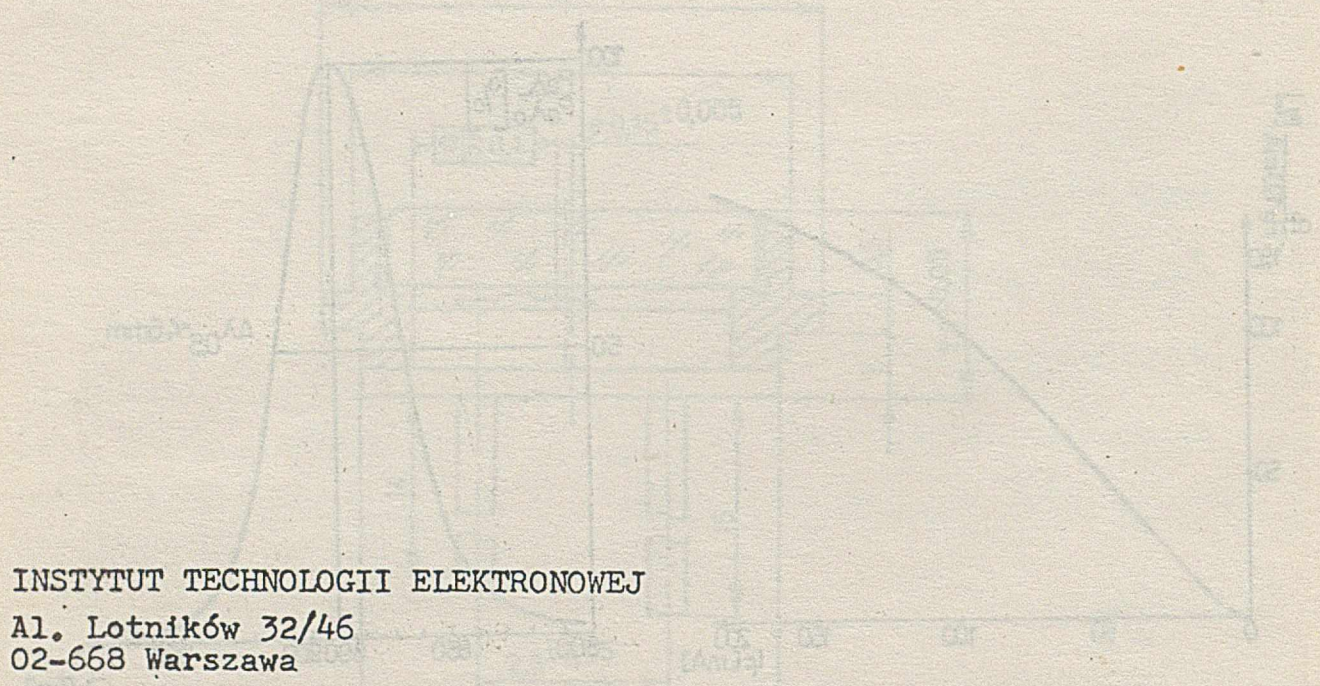
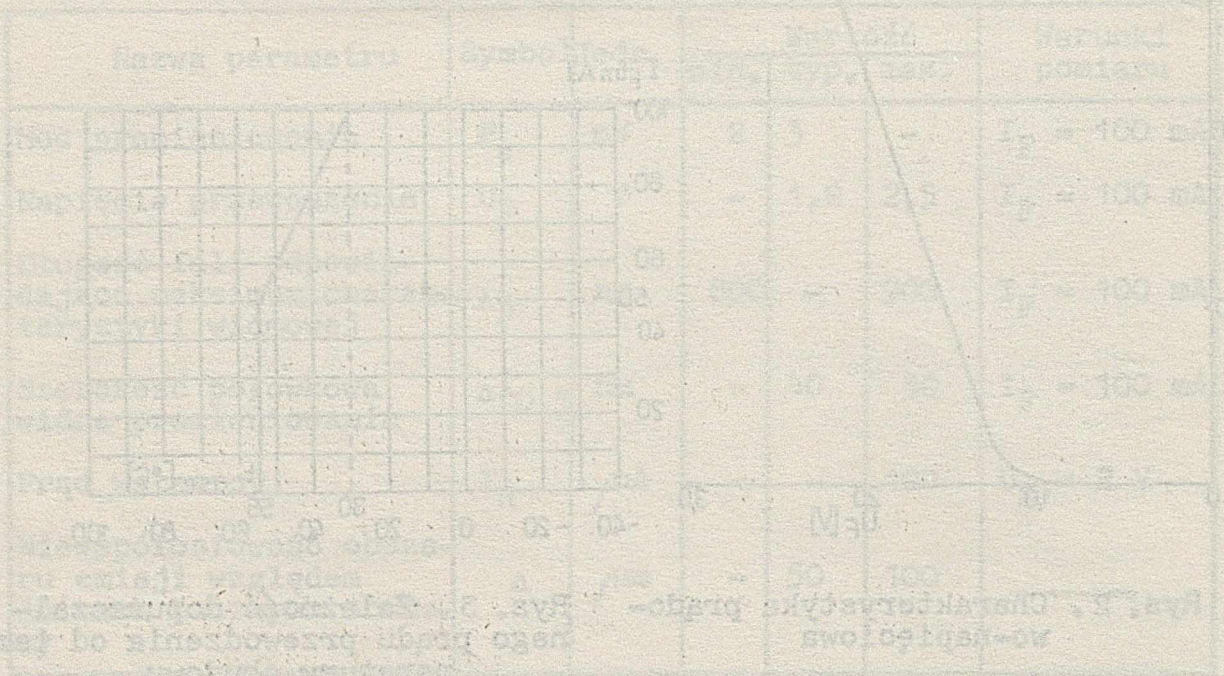


Rys. 4. Charakterystyka mocowo-prądowa



Rys. 5. Względny widmowy rozkład mocy promieniowania

PARAMETRY CHARAKTERYSTYCZNE



INSTYTUT TECHNOLOGII ELEKTRONOWEJ

Al. Lotników 32/46
02-668 Warszawa

tel. 43-54-01
tlx 815647
Cena 40 zł

Druk ZOINTE ITE zam. 48/88 n. 300

PRAWO REPRODUKCJI ZASTRZEŻONE